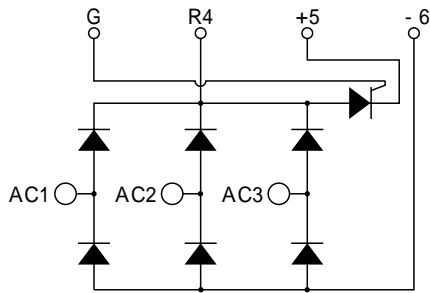
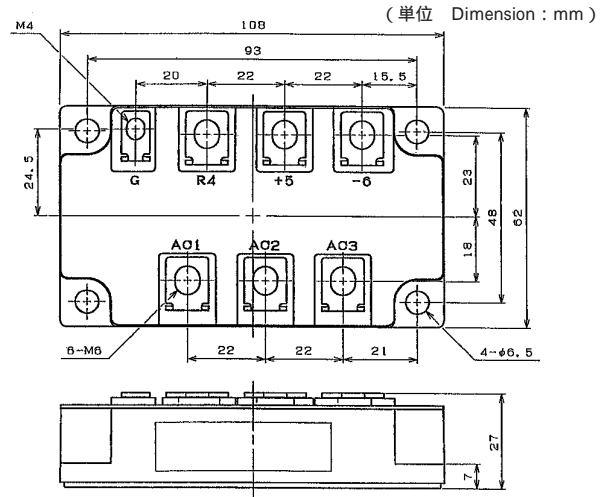


THYRISTOR	200A Avg 1600 Volts	PGH20016AM
-----------	---------------------	------------

回路図 CIRCUIT



外形寸法図 OUTLINE DRAWING



総合定格・特性 Part of Diode Bridge & Thyristor  
 最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均出力電流 Average Rectified Output Current	I <sub>o(AV)</sub>	三相全波整流 3-Phase Full Wave Rectified	T <sub>c</sub> = 90 (電圧印加なし) Non-Bias	200	A	
			T <sub>c</sub> = 65 (電圧印加あり) Bias	200	A	
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T <sub>jw</sub>	125 ~ 150 はサイリスタ部に順・逆電圧印加しない事 T <sub>j</sub> > 125 , Can not be Biased for Thyristor.	- 40 ~ + 150			
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>		- 40 ~ + 125			
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V <sub>iso</sub>	端子 - ベース間, AC 1分間 Terminal to Base, AC 1 min.	2500	V		
締付トルク Mounting Torque	F	ベース部 Mounting	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N・m
		主端子部 Terminal		M6	2.5 ~ 3.5	N・m
		ゲート端子部 Gate Terminal		M4	1.2 ~ 1.6	N・m

熱特性 Thermal Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value	単位 Unit
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(c-f)</sub>	ケース・フィン間(トータル), サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.06	/W

質量 Approximate Weight...約530g

ダイオードブリッジ部 (6素子) Part of Diode Bridge (6 dies)

最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐压クラス Grade	単位 Unit
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	PGH20016AM 1600	V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>	1700	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージ順電流 *1 Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repertive	1800	A
電流二乗時間積 *1 I Squared t	I <sup>2</sup> t	2 ~ 10ms	16200	A <sup>2</sup> s
許容周波数 Allowable Operating Frequency	f		400	Hz

\*1: 1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタモジュール

## 電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I <sub>RM</sub>	T <sub>j</sub> =125 , V <sub>RM</sub> =V <sub>RRM</sub>	20	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V <sub>FM</sub>	T <sub>j</sub> = 25 , I <sub>FM</sub> =200A	1.35	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部 - ケース間 (トータル) Junction to Case, Total	0.10	/W

\*1 : 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

## サイリスタ部 (1素子) Part of Thyristor (1die)

## 最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PGH20016AM		
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V <sub>DRM</sub>	1600		V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V <sub>DSM</sub>	1700		V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	1600		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>	1700		V

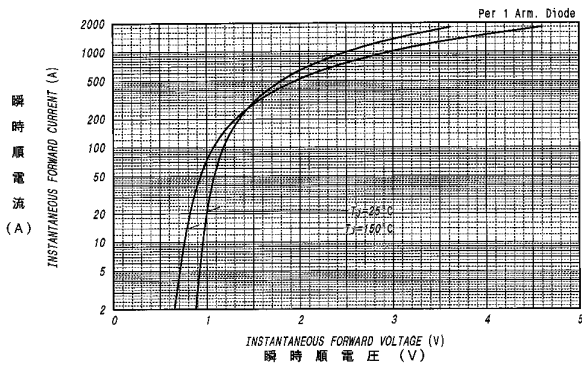
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	I <sub>TSM</sub>	50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	3200	A
電流二乗時間積 I Squared t	I <sup>2</sup> t	2 ~ 10ms	51200	A <sup>2</sup> s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V <sub>D</sub> =2/3V <sub>DRM</sub> , I <sub>TM</sub> =2·I <sub>O</sub> , T <sub>j</sub> = 125 I <sub>G</sub> =300mA, di <sub>G</sub> /dt=0.2A/μs	100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P <sub>GM</sub>		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P <sub>G(AV)</sub>		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I <sub>GM</sub>		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V <sub>GM</sub>		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V <sub>RGM</sub>		5	V

## 電気的特性 Electrical Characteristics

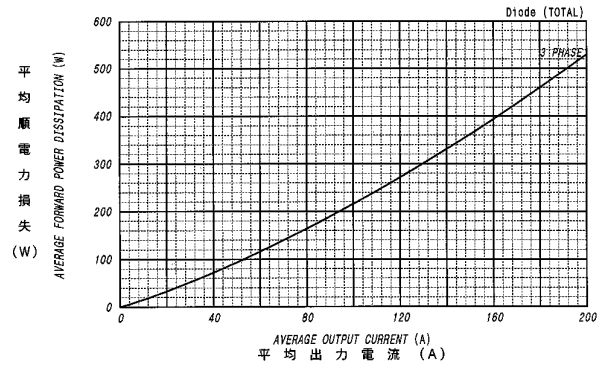
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I <sub>DM</sub>	T <sub>j</sub> =125 , V <sub>DM</sub> =V <sub>DRM</sub>			50	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V <sub>TM</sub>	T <sub>j</sub> =25 , I <sub>TM</sub> =200A			1.35	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I <sub>GT</sub>	V <sub>D</sub> =6V , I <sub>T</sub> =1A	T <sub>j</sub> = - 40		300	mA
			T <sub>j</sub> = 25		150	mA
			T <sub>j</sub> = 125		80	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V <sub>GT</sub>	V <sub>D</sub> =6V , I <sub>T</sub> =1A	T <sub>j</sub> = - 40		5.0	V
			T <sub>j</sub> = 25		3.0	V
			T <sub>j</sub> = 125		2.0	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V <sub>GD</sub>	T <sub>j</sub> =125 , V <sub>D</sub> =2/3V <sub>DRM</sub>	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	T <sub>j</sub> =125 , V <sub>D</sub> =2/3V <sub>DRM</sub>	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t <sub>q</sub>	T <sub>j</sub> =125 , I <sub>TM</sub> =I <sub>O</sub> , V <sub>D</sub> =2/3V <sub>DRM</sub> dv/dt=20V/μs, V <sub>R</sub> =100V, - di/dt=20A/μs		150		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t <sub>gt</sub>			6		μs
遅れ時間 Delay Time	t <sub>d</sub>	T <sub>j</sub> =25 , V <sub>D</sub> =2/3V <sub>DRM</sub> , I <sub>TM</sub> =3·I <sub>O</sub> I <sub>G</sub> =300mA, di <sub>G</sub> /dt=0.2A/μs		2		μs
立上がり時間 Rise Time	t <sub>r</sub>			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I <sub>L</sub>	T <sub>j</sub> =25		150		mA
保持電流 Holding Current	I <sub>H</sub>	T <sub>j</sub> =25		100		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部 - ケース間 Junction to Case			0.25	/W

定格・特性曲線

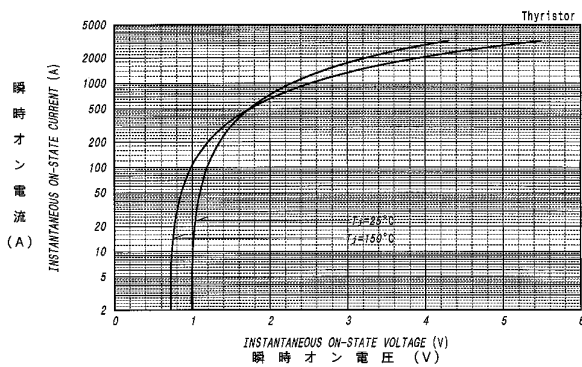
順電圧特性  
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



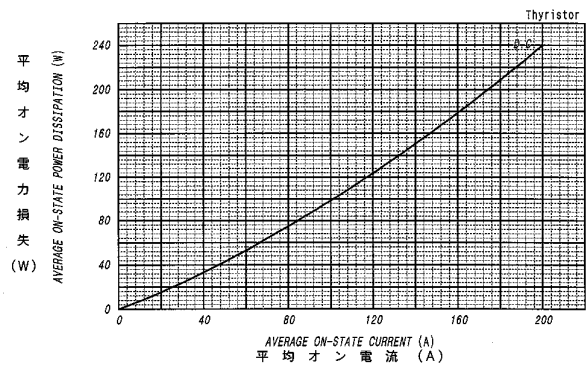
平均順電力損失特性  
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



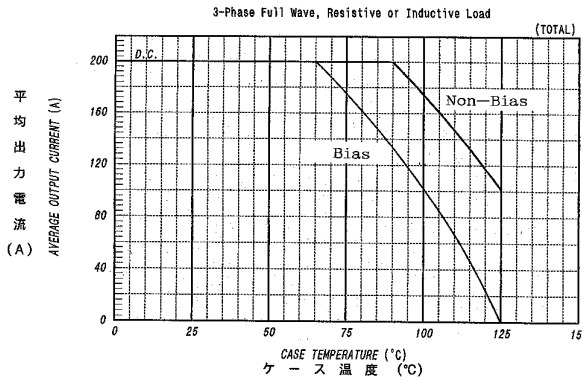
オン電圧特性  
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



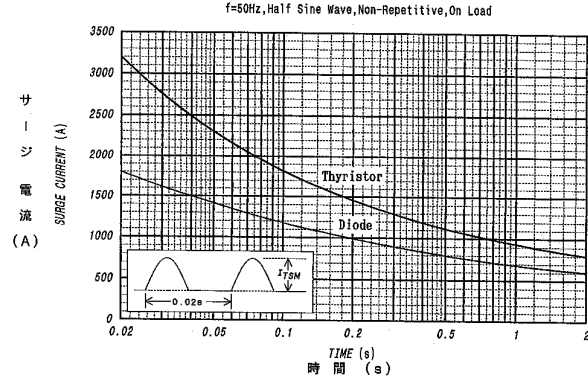
平均オン電力損失特性  
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION



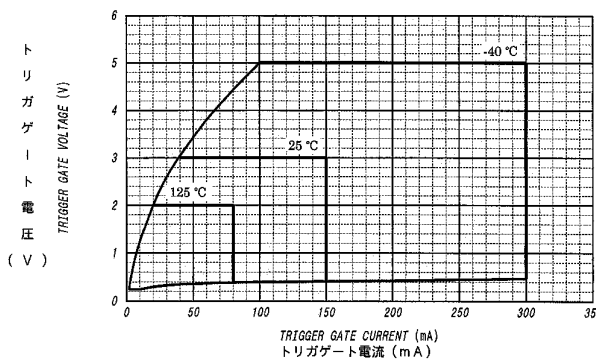
平均出力電流 - ケース温度定格  
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



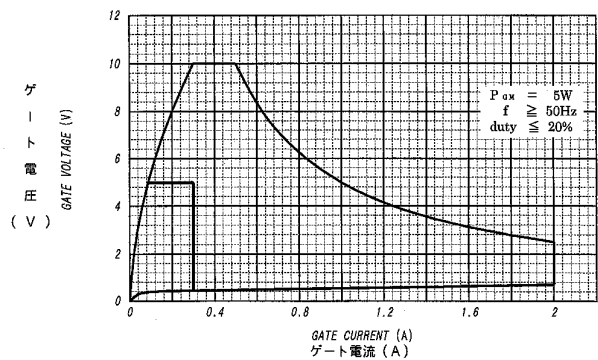
サージ電流定格  
SURGE CURRENT RATINGS



ゲート特性  
GATE CHARACTERISTICS



ゲート定格  
GATE RATINGS



サイリスタモジュール